



(11) **EP 1 145 328 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
H01L 29/808 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE1999/004019

(48) Corrigendum ausgegeben am:
17.06.2009 Patentblatt 2009/25

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2000/038246 (29.06.2000 Gazette 2000/26)

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
01.04.2009 Patentblatt 2009/14

(21) Anmeldenummer: **99967886.5**

(22) Anmeldetag: **17.12.1999**

(54) **SPERRSCHICHT-FELDEFFEKTTRANSISTOR MIT HOCH DOTIERTEN
VERBINDUNGSGBIETEN**

JUNCTION-GATE FIELD-EFFECT TRANSISTOR WITH HIGHLY DOPED CONNECTING AREAS
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP DOTE D'UNE COUCHE D'APPAUVRISSEMENT ET DE ZONES
DE CONNEXION HAUTEMENT DOPEES

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**

(74) Vertreter: **Maier, Daniel Oliver et al**
Siemens AG
CT IP Com E
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)

(30) Priorität: **22.12.1998 DE 19859502**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.10.2001 Patentblatt 2001/42

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 732 734 WO-A-98/49733
DE-A- 4 309 764 US-A- 5 323 040

(73) Patentinhaber: **SiCED Electronics Development
GmbH & Co KG**
91058 Erlangen (DE)

(72) Erfinder:
• **TIHANYI, Jenő**
D-85551 Kirchheim (DE)
• **MITLEHNER, Heinz**
D-91080 Uttenreuth (DE)
• **STEPHANI, Dietrich**
D-91088 Bubenreuth (DE)

• **SHENOY P M ET AL: "A NOVEL P+
POLYSILICON/N-SIC HETEROJUNCTION
TRENCH GATE VERTICAL FET" IEEE
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER
SEMICONDUCTOR DEVICES AND ICS,US,NEW
YORK, NY: IEEE, Bd. CONF. 9, 1997, Seiten
365-368, XP000800222 ISBN: 0-7803-3994-0**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 1 145 328 B8